

【11】證書號數：I889543

【45】公告日：中華民國 114 (2025) 年 07 月 01 日

【51】Int. Cl.：G01R31/28 (2006.01)

發明

全 7 頁

【54】名稱：晶粒點測方法

【21】申請案號：113134273

【22】申請日：中華民國 113 (2024) 年 09 月 10 日

【72】發明人：陳威竣 (TW) CHEN, WEI-JYUN

【71】申請人：台亞半導體股份有限公司

TAIWAN-ASIA SEMICONDUCTOR
CORPORATION

新竹市力行五路 1 號

【74】代理人：林義傑；劉彥宏；丁國隆

【56】參考文獻：

TW 200419688A

TW 201024765A

TW 201038954A

TW 201241945A

US 2013/0043897A1

US 2019/0049514A1

審查人員：張耕誌

【57】申請專利範圍

1. 一種晶粒點測方法，便於一點測機點測一晶圓上之複數晶粒，該晶圓上各該晶粒彼此交錯排列且各該晶粒之邊緣彼此串聯成一直線切割道，包含以下步驟：
等分各該晶粒為二相等區塊；
重設該點測機之一移動距離，其中該移動距離等於該二相等區塊間之一間距；及
改變該點測機之一點測頻率為每移動二個該移動距離後進行一次點測該些晶粒其中之一。
2. 如請求項 1 所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正三邊形晶粒。
3. 如請求項 1 所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正六邊形晶粒。
4. 如請求項 1 所述之晶粒點測方法，其中各該晶粒係一正八邊形晶粒。
5. 一種非四邊形晶粒點測方法，便於一點測機點測一晶圓上之複數非四邊形晶粒，該晶圓上各該非四邊形晶粒彼此交錯排列且各該非四邊形晶粒之邊緣彼此串聯成一直線切割道，包含以下步驟：
等分各該非四邊形晶粒為二相等區塊；
重設該點測機之一移動距離，其中該移動距離等於該二相等區塊間之一間距；及
改變該點測機之一點測頻率為每移動二個該移動距離後進行一次點測該些非四邊形晶粒其中之一。
6. 如請求項 5 所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正三邊形晶粒。
7. 如請求項 5 所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正六邊形晶粒。
8. 如請求項 5 所述之非四邊形晶粒點測方法，其中各該非四邊形晶粒係一正八邊形晶粒。

圖式簡單說明

圖 1 為一穿戴裝置中數個六邊形晶粒排佈之示意圖；

圖 2 為一實施例中一晶圓中數個正六邊形晶粒排佈之示意圖；

圖 3 為另一實施例中一晶圓中數個正六邊形晶粒排佈之示意圖；

圖 4 為圖 3 所示晶粒排佈下點測狀態之示意圖；

圖 5 為本發明晶粒點測方法下點測狀態之示意圖；及

(2)

圖 6 為本發明晶粒點測方法之流程示意圖。

10

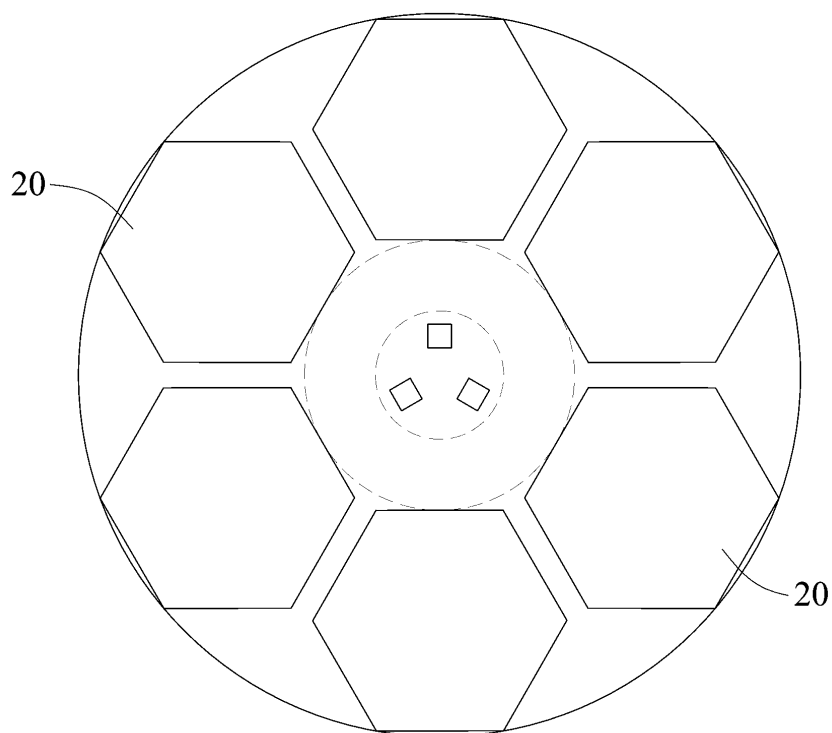


圖1

(3)

1

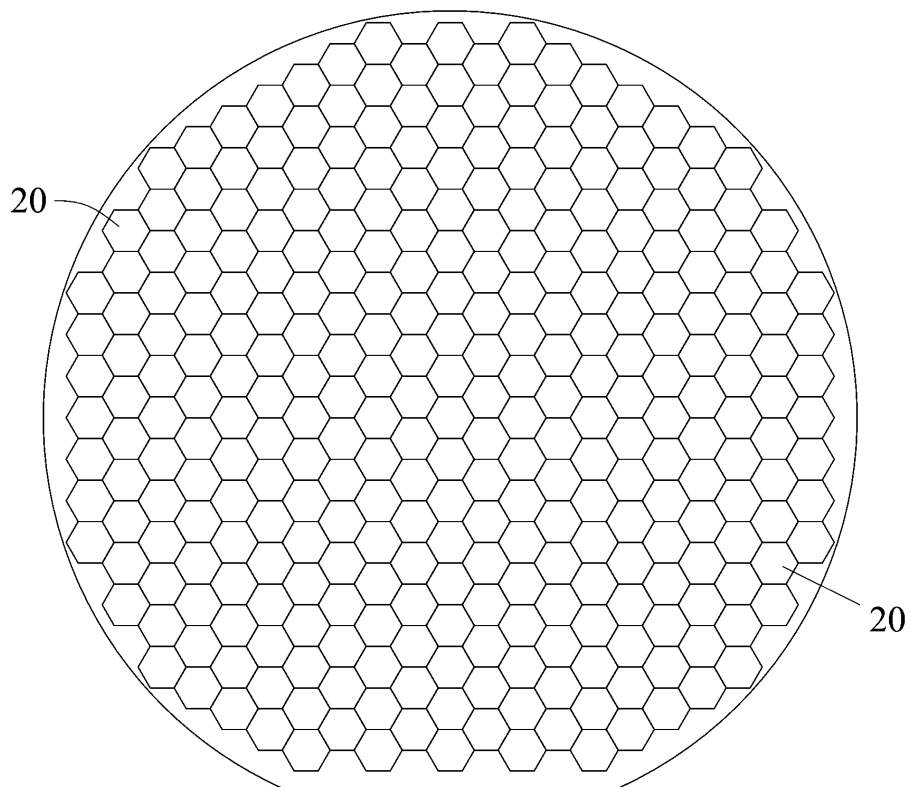


圖2

(4)

1

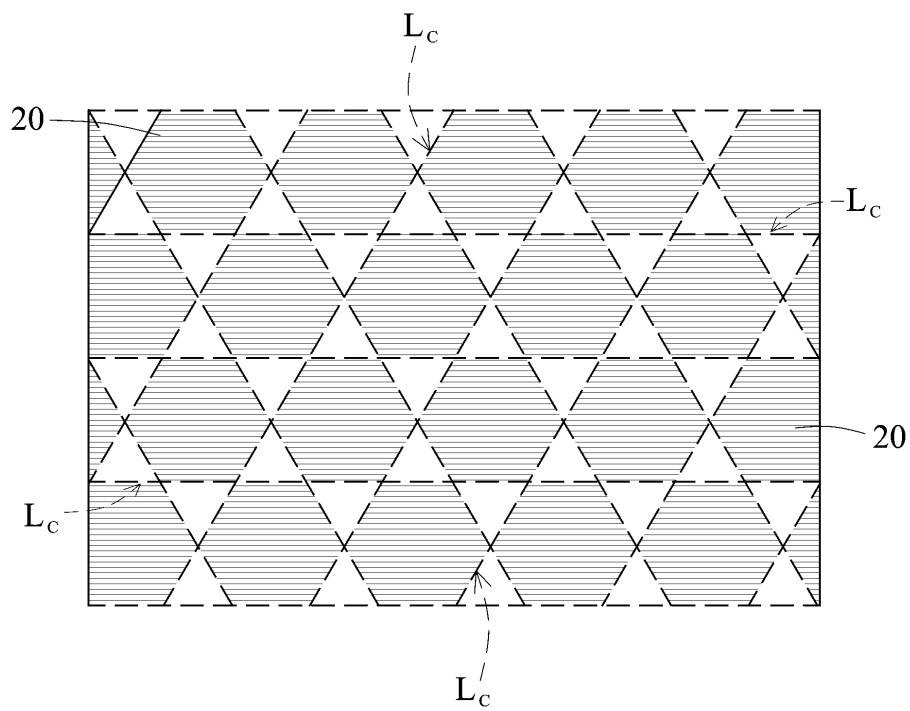


圖3

(5)

1

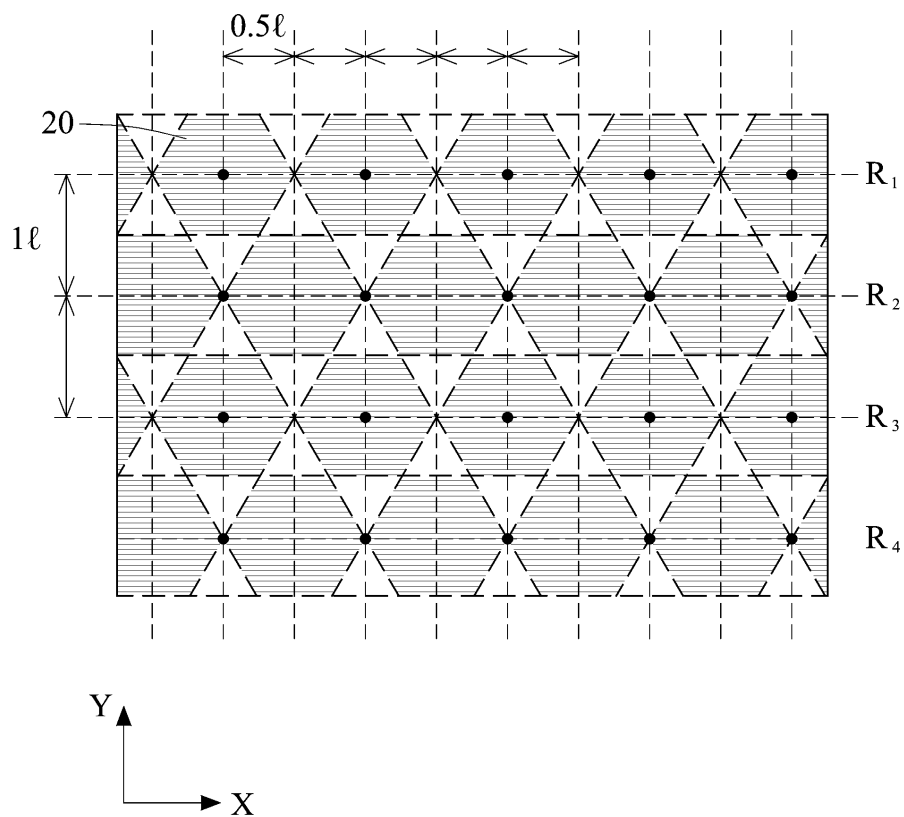


圖4

(6)

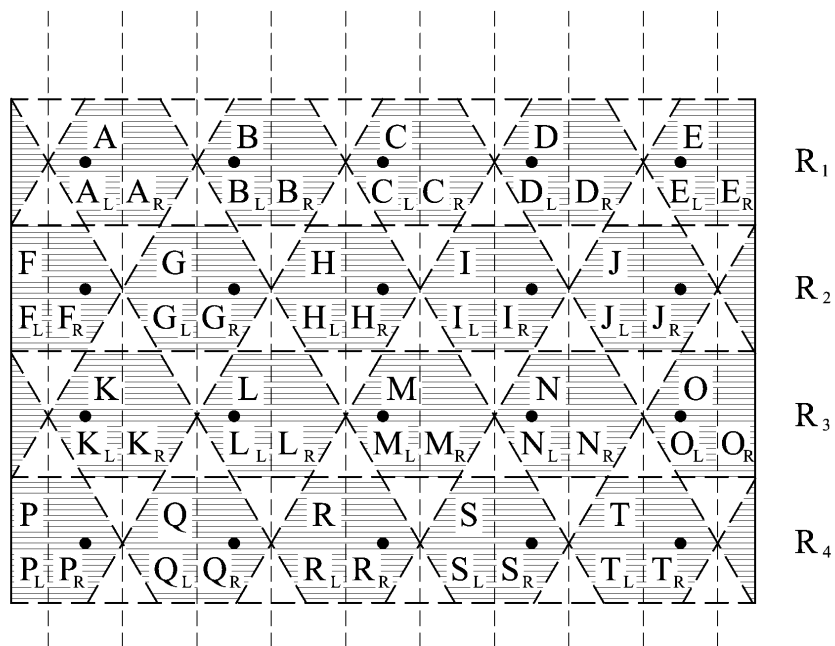


圖5

(7)

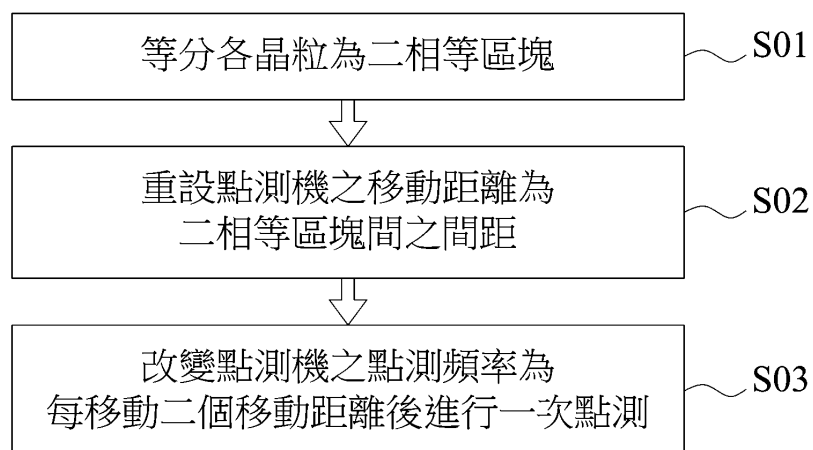


圖6